

國立中興大學技術授權遴選廠商公告資料表

公告主旨：國立中興大學技術移轉遴選廠商公告	公告日期：108/04/19
公告編號： 108-015	
<p>內容：國立中興大學技術移轉遴選廠商公告</p> <p>一、技術名稱：垂直導通結構發光二極體的製作方法及其製品</p> <p>二、專利資訊：I599069</p> <p>三、技術來源：經濟部</p> <p>四、技術內容：</p> <p> 本發明主要提供一種垂直導通結構發光二極體的製作方法，先於氧化鋁單晶基材上形成至少二層二維石墨烯結構後，以鍍膜技術形成將石墨烯結構嵌覆且晶體結構與氮化鎵系列半導體材料相匹配的緩衝磊晶結構而製作出磊晶用分裂層體，然後用磊晶技術磊晶成長由氮化鎵系列半導體材料構成的磊晶層體，再用導電材料形成與磊晶層體電連接的永久基材，之後，令磊晶用分裂層體沿該等石墨烯結構間崩裂分離而使氧化鋁單晶基材被移除，最後用導電材料於磊晶用分裂層體崩裂分離的結構面上形成與磊晶層體電連接的電極，製作得到垂直導通結構發光二極體。</p>	
<p>五、計畫執行機關/系所：精密工程研究所、材料科學與工程學系</p> <p> 技術發明人：洪瑞華、武東星教授</p>	
<p>六、廠商資格：</p> <p>1、廠商業別：光電產業</p> <p>2、應具備之專門技術：磊晶技術、LED 元件製程技術</p> <p>3、應有之機具設備：有機金屬氣相磊晶反應設備、黃光微影設備、金屬蒸鍍/濺鍍設備、化學蝕刻設備等</p> <p>4、應有之研究或技術人員人數：10人</p> <p>5、其他：無</p>	
<p>七、預期利用範圍及產品：發光二極體、LED 顯示陣列晶片、顯示器...等光電產品。</p>	
<p>八、公開方式：</p> <p>（一）技術資料於網際網路上公開。</p> <p> 網址：國立中興大學首頁 http://www.nchu.edu.tw/index1.php</p> <p> 國立中興大學產學研鏈結中心 http://140.120.49.189/about1.php</p> <p>（二）逕向國立中興大學產學研鏈結中心葉小姐及黃小姐索取相關資料。</p>	
<p>九、申請方式：</p> <p>（一）由網際網路下載申請表格，填妥後逕送至國立中興大學產學研鏈結中心。</p> <p>（二）亦得逕至中興大學索取技術資料及申請表格。</p> <p>地點：台中市興大路145號（國農中心大樓2F 234室）</p> <p>承辦人員：葉小姐/黃小姐 聯絡電話：(04)22851811#21.20 傳真：(04)22851672</p> <p>e-mail：jmine3388@nchu.edu.tw、yenling@nchu.edu.tw</p>	